








	<h2>SIJ400DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIJ400DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 32A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIJ400DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJ400DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 32A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 32A (Tc) 5W (Ta), 69.4W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 69.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7765pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIJ400DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIJ400DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIJ400DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIJ400DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIJ458DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ420DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ420DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ400DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 32A PPAK SO-8</p>
 <p>SIJ458DP-T1-E3 VISHAY SIJ458DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIJ392 VISHAT VISHAT SOP-8</p>	 <p>SIJ438DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 80A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ438DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 80A PPAK SO-8L</p>

heiße Teile

Mehr

04025A120GAT2A	06033A101FAT2A	12065C274MAT2A	D 1210ZD106MAT2A	AD5660CRM-2-REEL7
AM29F040B-55EC	ATMEGA8L-8PI	BLA2ABD221SN4D	BSF050N03LQ3G	BSS138WL6327
BTA04-600S	C3216X8R1C335K160AB	CL21C221GBANNC	DAC088S085CIMTX/NOPB	DSSK50-0025B
FB20R06KL4	FG3000BV-90	GRM0335C1H6R1DD01D	HSM91349152	IPI50CN10NG
IR1155STRPBF	KC355WD72J564MH01K	KTD2536EHD-TR	L9777B13TR	LT1054IDWR
LT3467AIDDB#TRMPBF	LTC3220EPF#TRPBF	MCH3312-TL	MG50N2YS1/140	PDSB5016
PM50CTJ060-03	PQ012ENB1ZPH	PW3300B-30L	SIJ400DP-T1-GE3	SIJ420DP-T1-GE3
SIJ420DP-T1-GE3	SIJ458DP-T1-E3	SIJ462DP-T1-GE3	SIJ462DP-T1-GE3	SIJ484DP-T1-GE3
SIJ484DP-T1-GE3	SIJ800DP-T1-E3	SMBJ6.5CA-CT7	SPD25N06S2-40	SUP65P06-20
TL061BIDT	V28A12T200BL3	VE-201-CY	VE-2T3-CX	ZJYS51R5-2PT

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited